

Šolski Center Velenje
Višja Strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

Skupina B

Predmet: Elektronska vezja in naprave
Datum izvajanja vaje: 13.11.2007

Vaja 5

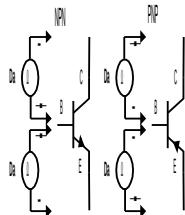
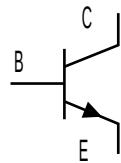
Študent: D. M.

Besedilo vaje

Sodobna zasnova in zanesljivost delovanja elektronskih vezij zahtevata dobro poznavanje karakteristik in uporabnih lastnosti polprevodniških komponent. To še posebno velja za močnostne komponente, ki morajo biti ustrezno izbrane in optimalno dimenzionirane. Polprevodniške komponente v močnostnih stopnjah so pogosto vzrok odpovedi, zato je poznavanje metod hitrega preverjanja in odkrivanja napak bistvenega pomena za rešitev problema. **Cilj vaje je utrditev teh znanj na značilnejših komponentah kot so bipolarni tranzistor, MOSFET tranzistor, IGBT, GTO, tiristor in triac.**

Bipolarni tranzistor

NPN

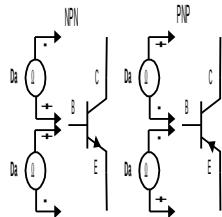
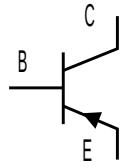


BC 141

1	2	3	Komentar
+	-		Ne
-	+		Da
	+	-	Da
	-	+	Ne
+		-	Ne
-		+	Ne

NPN tranzistor je ispraven

PNP



BC 161

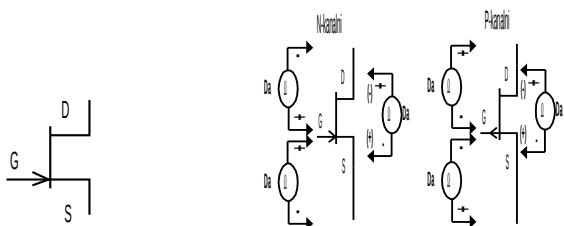
1	2	3	Komentar
+	-		Da
-	+		Ne
	+	-	Ne
	-	+	Da
+		-	Ne
-		+	Ne

PNP tranzistor je ispraven

Unipolarni tranzistor

FET

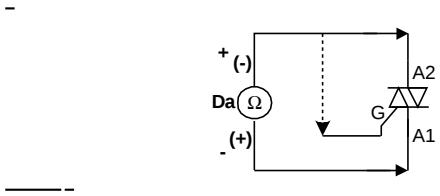
N – kanalni



BF245 C

1	2	3	Komentar
+	-		Da
-	+		Ne
	+	-	Da
	-	+	Da
+		-	Da
-		+	Ne

Triak

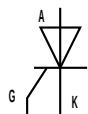


TIC 236 M

1	2	3	Komentar
+	-		Ne
-	+		Ne
	+	-	Ne
	-	+	Ne
+		-	Da
-		+	Da

Triak smo vžgali z negativnim tokom I_G . Sprožili smo ga z kratkim stikom med A_2 in G , ko smo kratek stik odstranili je bil še triak vedno vžgan.

Tiristor



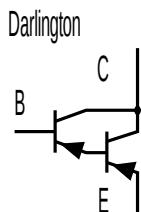
TIC 106 M

1	2	3	Komentar
+	-		Ne
-	+		Ne
	+	-	Ne
	-	+	Ne
+		-	Ne
-		+	Da

- darlington

Tiristor hitro preizkušamo tako, da ohmmeter priključimo med A in K tako, da je pozitivni potencial ohmmetra na A, nato pa ne da bi prekinili ta tokokrog kratko spojimo še A-G in s tem povzročimo vžig tiristorja. Po odstranitvi povezave med A in G mora tiristor ostati vžgan.

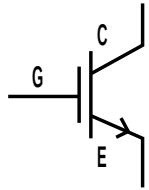
PNP



BDW 94C

1	2	3	Komentar
+	-		Ne
-	+		Da
	+	-	Da
	-	+	Ne
+		-	Ne
-		+	Da

IGBT



BUP 203

1	2	3	Komentar
+	-		Ne
-	+		Ne
	+	-	Ne
	-	+	De
+		-	Ne
-		+	Ne

Ko IGBT nabijemo s pozitivno elektrino – prevaja, ko pa ga nabijemo z negativno pa ne prevaja.

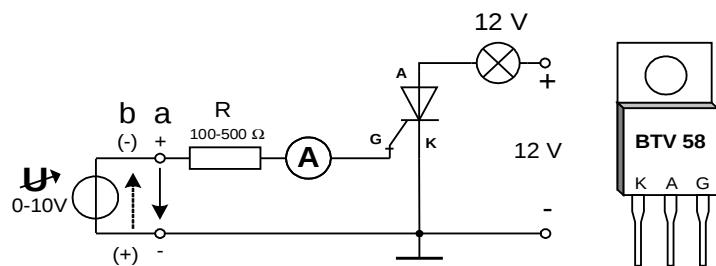
Močnostni FET

1	2	3	Komentar
+	-		Ne
-	+		Ne
	+	-	Da
	-	+	Ne
+		-	Ne
-		+	Ne

Za samozaporni MOSFET (Metal Oxid Semiconductor) je značilno, da je kanal pri $U_{GS} = 0V$ popolnoma zaprt, pri prisotni U_{GS} pa se upornost kanala sorazmerno zmanjšuje glede na velikost napetosti (za N-kanal pozitivna, za P-kanal negativna).

GTO

Delovanje GTO-ja lahko preizkusimo na improviziranem vezju z bremenom. Vžigna karakteristika je podobna kot pri tiristorju medtem ko je tok gašenja nekajkrat večji od toka vžiga in je odvisen od velikosti toka, ki ga GTO prevaja.



U Napajalna (V)	I _{Vklop} (A)	I _{Izklop} (A)	I _{AK vklop} (mA)
6	13,2mA	42mA	0,98mA

12	13,6mA	72mA	1,67mA
----	--------	------	--------

Pri GTO višamo napetost tako dolgo da ga vžgemo. Vžge nam pri 2,2V. nato obrnemo polariteto in spet tako dolgo višamo, da nam ugasne. Ugasne nam pri 7,7V.